

DHA<sup>®</sup>

QJ/DHA 09.01-2018

50N06

## N-沟道 MOSFET 功率晶体管

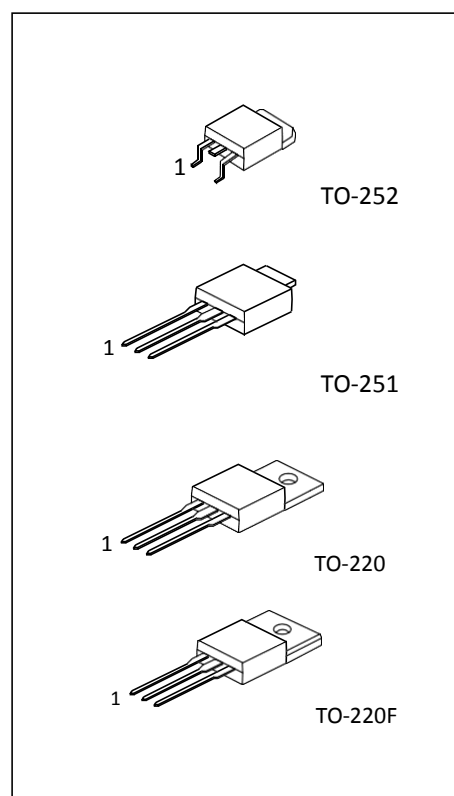
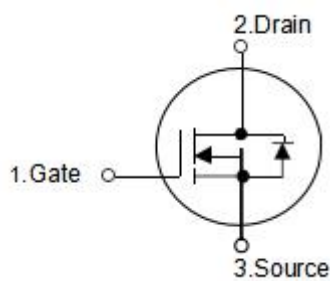
## 描述

50N06 是三端硅器件，电流传导能力约为 50A，开关速度快。低导通电阻  $R_{DS(on)}=23m\Omega$ （最大），击穿电压额定值为 60V，最大门限电压为 4V。

## 用途

主要适用于电子镇流器和低功率开关电源。

## 等效电路图



## 电参数 (Tamb = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
$BV_{DSS}$	漏极-源极 击穿电压	V	60	-	-	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$I_D$	漏极连续电流	A	-	-	50	$T_j = 25^\circ C$
$R_{DS(on)}$	静态 漏极-源极 导通电阻	m $\Omega$	-	18	22	$V_{GS}=10V, I_D=25A$
$V_{GS(th)}$	栅极门限电压	V	2.0	-	4.0	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
$I_{DSS}$	漏极-源极 漏电流	$\mu A$	-	-	10	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$
$I_{GSS}$	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
$T_j$	工作结温	$^\circ C$	- 55 ~ +175			
$T_{STG}$	储存温度范围	$^\circ C$				